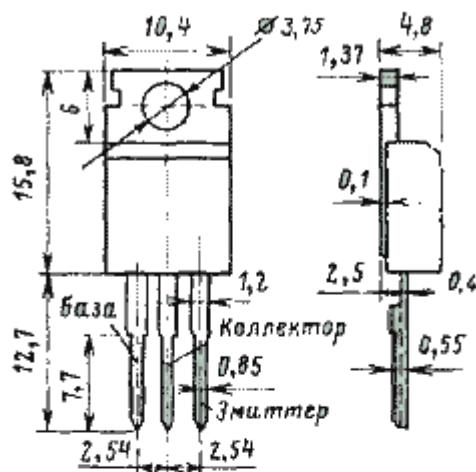


KT829

KT829А, KT829Б, KT829В, KT829Г



Транзисторы кремниевые мезапластиарные n-p-n составные универсальные низкочастотные мощные

Предназначены для работы в усилителях низкой частоты, ключевых схемах

Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами
Обозначение типа приводится на корпусе

Масса транзистора не более 2 г

Электрические параметры

Границное напряжение при $I_K = 100$ мА не менее:

KT829А	100 В
KT829Б	80 В
KT829В	60 В
KT829Г	45 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 3,5$ А, $I_B = 14$ мА не более

2 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 3,5$ А, $I_B = 14$ мА не более

2,5 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{K\bar{E}} = 3$ В, $I_K = 3$ А не менее

при $T_k = 298$ К и $T = 358$ К	750
при $T_k = 233$ К	100

Модуль коэффициента передачи тока при $f = 10$ МГц, $U_{K\bar{E}} = 3$ В, $I_K = 3$ А не менее

0,4

Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{K\bar{E}} = U_{K\bar{E}}$ макс, $R_{K\bar{E}} = 1$ кОм не более

при $T_k = 298$ К и $T = 233$ К	1,5 мА
при $T_k = 358$ К	3 мА

Обратный ток эмиттера при $U_{B\bar{E}} = 5$ В не более

2 мА

Предельные эксплуатационные данные